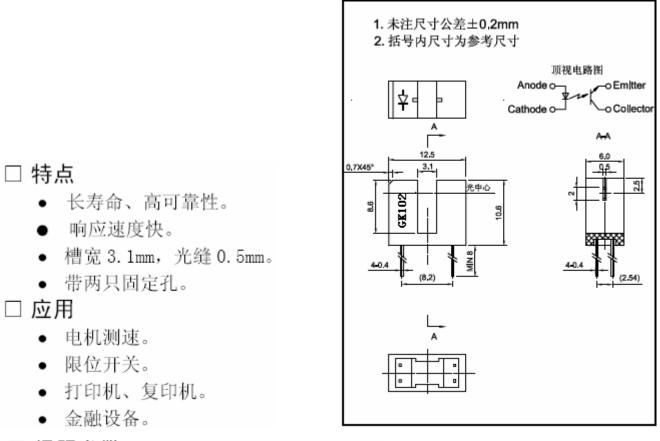
<u>GK102</u>

GK102是单光束红外光电传感器,由进口高发射功率的砷化镓(砷铝镓)红外发射管和高灵敏度的光敏晶体管组成。



🗆 极限参数

(Ta=25℃)

.∟ 1%	(Ta=25 C)			
项 目		符号	数 值	单位	
输入	耗散功率	PD	75	mW	
	反向电压	VR	5	v	
	正向电流	IF	50	mA	
	脉冲电流(*1)	IFP	1	A	
输出	集电极功耗	Pc	75	mW	
	集电极电流	Ic	30	mA	
	集-射电压	VCEO	30	v	
	射-集电压	VECO	5	v	
工作温度		Topr	-25∽+85	°C	
储存温度		Tstg	-40∽+85	°C	
	焊接温度(*2)	Tsol	240	°C	
注:*	1.tw≦100µs	T=10ms	*2. 焊接时间≦5s		

□ 光电特性

(Ta=25℃)

项 目		符 号	测试条件	最 小	典 型	最 大	单位
输入	正向压降	VF	IF=10 mA	-	1.2	1.6	V
	反向电流	IR	Vr=5V	-	-	10	μA
	波长	λρ	IF=10 mA	-	940	-	nm
输出	集电极暗电流	ICEO	$E_e=0mW/cm^2$ Vcm=20V	-	-	100	nA
	集电极光电流	IL	Vcm=5V IF=10mA RL=500Ω	1.0	2	-	mA
	饱和压降	VCE(sat)	IF=10 mA Ic=0.1 mA	-	-	0.4	v
传输特性	上升时间	tr	Vcc=5V Ic=2 mA	_	5	_	μs
	下降时间	tf	RL=100 Ω	-	5	-	μs